FOR USE BY ELECTRICIANS OVERSEAS:

最新トランジスタ規格表 (New Transistor Manual) lists all the transistors registered with the Electronic Industries Association of Japan (EIAJ), arranged in a manner easy to look up. We hope that you will make full use of the data provided in this manual by referring to the Japanese-English translation key given below.

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a=25°C)					電気的特性 (T_a=25°C)												外形	備考
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO}最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルスh_{FE} V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	$f_{\alpha b}$ f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ h_{ie}(real)* Ω)		
1	2	3	4	5					6		7		8						9	10		11	12

1 TYPE NUMBER

2 ORIGINAL MANUFACTURER

3 USES

4 MATERIAL AND STRUCTURE

5 MAXIMUM RATINGS

6 I_{CBO} MAXIMUM VALUE AND V_{CB} VALUE (CRITERIA FOR MEASURING I_{CBO})

7 STANDARD VALUE OF DC/PULSE h_{FE} AND V_{CE} , I_C (CRITERIA FOR MEASURING DC/PULSE h_{FE})

8 STANDARD VALUE OF h PARAMETERS AND BIAS V_{CB} , I_E (CRITERIA FOR MEASURING h PARAMETERS)

* INDICATES VALUE IN GROUNDED-BASE OPERATION, OTHERWISE VALUE IN EMITTER-GROUNDED OPERATION.

9 $f_{\alpha b}$ OF RF CHARACTERISTIC, EXCEPT IN CASE OF * WHICH INDICATES VALUE OF f_T.

10 C_{ob} AND $r_{bb'}$ OF RF CHARACTERISTICS EXCEPT IN CASE OF * IN $r_{bb'}$ COLUMN WHICH INDICATES VALUE OF h_{ie} (real)

11 OUTLINE

12 REMARKS

：とコンプリ： COMPLEMENTARY TO ·····

型名	社名	用途	構造	最大定格 (T_a = 25°C)					電気的特性 (T_a = 25°C)													外形	備考
				V_{CBO} (V)	V_{EBO} (V)	I_C (mA)	P_C (mW)	T_j (°C)	I_{CBO} 最大値 (μA)	V_{CB}(V)	直流又はパルス h_{FE}	V_{CE}(V)	I_C(mA)	バイアス V_{CB}(V)	I_E(mA)	h_{fe} h_{fb}*	h_{ie} h_{ib}* (Ω)	h_{re} h_{rb}* (×10⁻⁴)	h_{oe} h_{ob}* (μ℧)	f_{ab} f_T* (Mc)	C_{ob} (pF)	$r_{bb'}$ $h_{ie(real)}$* (Ω)		
2SC1841	日電	AF	Si. E	120	5	50	500	125	0.05	120	600	6	1	6	−1					110*	1.6		138	
〃 1842	〃	RF. LN	〃	40		100	250	125	0.1	40	500	6	1	6	−1	NF=1.2dB (6V, 1mA, 100Hz)				120*	3.5	50*	138	
〃 1843	〃	〃	〃	60		100	250	125	0.1	60	400	6	1	6	−1	NF=0.8dB (6V, 1mA, 100Hz)				110*	3.5	50*	138	
〃 1844	〃	AF. LN	Si. E	60	5	100	500	125	0.05	60	400	6	1	6	−1	V_{NO}<45mV (5V, 1mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)				100*	4.8		138	2SA991 とコンプリ
〃 1845	〃	〃	〃	120	5	50	500	125	0.05	120	600	6	1	6	−1	V_{NO}<40mV (5V, 1mA, R_G=100kΩ, A_v=80dB)				110*	1.6		138	2SA992 とコンプリ
〃 1846	松下	PA	Si. EP	45	5	1 A	1.2W	150	0.1	20	160	10	500	10	−50					200*	15	3.5k*	222	2SA885 とコンプリ
〃 1847	〃	〃	〃	50	5	1.5A	1.2W	150	1	20	120	5	1 A	5	−500					150*	50	3.3k*	222	2SA886 とコンプリ
〃 1848	〃	〃	〃	70	5	2 A	1.2W	150	1	40	130	5	1 A	5	−500					150*	50	3 k*	161	2SA887 とコンプリ
〃 1849	〃	RF. AF	〃	30	5	100	350	135	1	10	250	10	2	10	−2	250	5 k	0.4	20	150*	3.5	70	138D	
〃 1850	〃	〃	〃	60	5	100	350	135	1	10	250	10	2	10	−2	250	5 k	0.4	20	150*	3.5	70	138D	
〃 1851	〃	PA	〃	30	5	500	625	135	0.1	20	160	10	150	10	−50					200*	6	3.5k*	138D	2SA890 とコンプリ
〃 1852	〃	〃	〃	60	5	500	625	135	0.1	20	160	10	150	10	−50					200*	6	3.5k*	138D	2SA891 とコンプリ
〃 1853	〃	RF.Conv.Mix Osc	〃	30	5	30	250	125	1	10	250	10	1	10	−1					230*	1.3	35	138	
〃 1854	〃	RF. AF	〃	30	5	50	250	125	1	10	200	5	2	5	−2	220	5 k	0.4	20	150*	2.2	70	138	
〃 1855	日立	RF	Si. Pa	20	3	20	250	125	0.1	20	20~200	10	2	10	−2	G_{pe}=28dB (V_{CC}=12V, I_C=4mA, f=45MHz)				550*	C_{re} 0.35		138C	
〃 1856	〃	〃	〃	20	3	20	250	125	0.1	20	20~200	10	2	10	−2	G_{pe}=22dB (V_{CC}=12V, I_C=2mA, f=200MHz)				550*	C_{re} 0.35		138C	
〃 1857	〃	〃	Si. T	300	5	100	800	150	1	250	100	20	20	20	−20					80*	3	20*	84B	
〃 1858																								
〃 1859	ソニー	RF	Si. E PaMe	25	5	1.5A	500	120	0.2	25	180	2	100	10	−10					140*	15	$C_c r_{bb'}$ 250pS	138	
〃 1860	日電	SW	Si. E	150	7	2 A	800	150	1	100	70	5	100			t_{on}<0.5μS, t_f<0.5μS t_{stg}<1μS							84B	
〃 1861	〃	〃	〃	300	7	2 A	800	150	10	250	60	5	100			t_{on}<1μS, t_f<1μS t_{stg}<2μS							84B	
〃 1862	〃	〃	Si. T	450	7	2 A	800	150	10	400	40	5	100			t_{on}<1μS, t_f<1μS t_{stg}<2.5μS							84B	
〃 1863	〃	〃	Si.EMe	150	7	7 A	40W (T_c=25°C)	150	100	100	>20	5	3 A			t_{on}<1μS, t_f<1μS t_{stg}<2μS							134	
〃 1864	〃	〃	〃	300	7	7 A	40W (T_c=25°C)	150	100	250	>20	5	3 A			t_{on}<1μS, t_f<1μS t_{stg}<2.5μS							134	
〃 1865	〃	〃	Si.TMe	450	7	7 A	40W (T_c=25°C)	150	100	400	>15	5	3 A			t_{on}<1μS, t_f<1μS t_{stg}<2μS							134	
〃 1866	〃	〃	〃	150	7	7 A	80W (T_c=25°C)	150	100	100	>20	5	3 A			t_{on}<1μS, t_f<1μS t_{stg}<2μS							102	
〃 1867	〃	〃	Si.EMe	300	7	7 A	80W (T_c=25°C)	150	100	250	>20	5	3 A			t_{on}<1μS, t_f<1μS t_{stg}<2μS							102	
〃 1868	〃	〃	Si.TMe	450	7	7 A	80W (T_c=25°C)	150	100	400	>15	5	3 A			t_{on}<1μS, t_f<1μS t_{stg}<2μS							102	
〃 1869	〃	〃	〃	150	7	10A	100W (T_c=25°C)	150	100	100	>20	5	5 A			t_{on}<1μS, t_f<1μS t_{stg}<2μS							102	
〃 1870	〃	〃	〃	300		10A	100W (T_c=25°C)	150	100	250	>20	5	5 A			t_{on}<1μS, t_f<1μS t_{stg}<2μS							102	